This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

117777

JP 357045959 A MAR 1952

(54) RESIN-SEALED SEMICONDUCTOR DEVICE

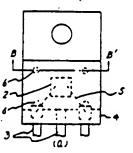
(11) 57-45959 (A) (43) 16.3.1982 (19) JP (21) Appl. No. 55-121513 (22) 2.9.1980 (71) NIPPON DENKI K.K. (72) SHINICHI AKASHI (51) Int. Cl². H01L23.28

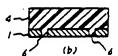
₽.

PURPOSE: To improve the adherence of a resin scaled simiconductor device by forming a hole at a position isolated from the mounting part of a semiconductor element

on a heat dissipating plate, covering and filling sealing reain at the hole part.

CONSTITUTION: Holes 6 are formed at four positions sufficiently isolated from the mounting part of a semiconductor element 2 on a heat dissipating plate 1, are covered with resin 4, and the resin is also filled in the hole 6. Since the resin is buried to the part of the resin is also filled in the hole 6. Since the resin is buried to the part of the resin is adherent in the hole 6. even in the holes 6, its adherence is not decreased even at high temperature, and introduction of moisture can be sufficiently prevented.







母 日本国特許庁 (JP)

3)特件出版公開

②公開特許公報(A)

昭57-45959

@Int. Cl.³ H 01 L 23/28

識別に号

厅内整理备号 7738-5F

砂公開 昭和57年(1982)3月16日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 2 頁)

8樹脂對止型半導体裝置

②特 願 8255-121513

②出 願 昭55(1980)9月2日

②発 明 者 明石進一

東京都港区芝五丁目33番1号日

本電気株式会社内

の出 願 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

少代 理 人 弁理士 内原管

M M 4

1. 免别の名称 實施對止型半導体養量

2 特許技术の概要

放出板とこの放射板に固定された半球体象子とこの半球体象子を包使する対止機能とを得えた機能対止機半球体機能にかいて、機能放射板には機能や呼ばれまり機能器から離れた位置に大水あけられ、この大部分をでも前記対止機能が低い後でよった内に元気されていることを特徴とする機能対止機半球体無限。

1. 元男の弊級な政务

本発明は質益質止益単導体機能、特に収集収が 質疑の外に適出した實際側止数単導体機能に過す るものである。

一般に資産制止量学等体質をだかいては、外部 環境の影響を受けやすく、気管制止等数を用いた 半導体質量化比べ信頼性が劣るという欠点があった。 毎代耐促性に対しては、一般化金属からなる故無視と耐止資理との哲療性が完分でないるに、その境界症からの水の使入を完全に防止することは厳しい。 放無視と対止制証との哲理性を上げる為に、位来は、(1)放無視質面に交通をつける。(2)放無視の資理対止される部分にY並解等の責む入れる。(3)対止資理として金属と管理性の具好でものを使用する。 などの対策を実施しているが、いずれも元分を効果は得られていない。

すをわち、無1個(a)。(b)化従来の割除対止競争 事件機能の一切の平面面とせのAーA/ 所面面を 示す。低化シいて、矩形の金属製放制板1の片面 の一方に片等った部分化単導体果子2が開着され、 との間層面質にシいて、単導体果子2 だせの引出 しリード3 と共に対止機能4 により包値されて外 事業類域から提載されている。5 は菓子と引出し リードも接続するボンディングワイヤである。

しかしながら、とのような従来の半導体展配で は、質止者は4 と放無収1 とは単れ資献している

11ME57- 45959(2)

だけで、いわける、喰いつき、がないため、特化 高速では質症と放射変との間の熱寒法の気により 密度性が低下してしてうという欠点があった。

本発明の目的は、上記の欠点を改善するもので、 放起板と例止質器との間の歯増性をよくし、よっ て、水分の投入することなどが防止されて値収性 の向上された資産例止型半導体機関を提供すると とにある。

本発列の資程列止型中導体模型は、放射板としの取削板に固定された中導体表子としの中導体表子を包修する例止資産とを侵え、さらに数配放制板には数配半導体表子の固着部から離れた位置に 大があけられ、前記例止資産はこの大部分まで優い被すりかつ大内に充填されている構成を有する。 つぎに本角質を実施例により収明する。

第2回(a)。(b)は不免労の一支税外の平成成シェ びそのB-B/新面値である。

第2回(a),(b)にかいて、本発明では、第1回(a),(b)に示す従来明と比べて、放無値1には、単導体表子2の回着部から十分遅れた位置の4回所に穴

6 が設けられ、この犬の部分までも対止保証 4 代より低い表さつているが、さらに犬 6 の中にも元表されている。

とのように欠るを投け、との欠の中にも対止依 近4 が進め込まれているととにより、放無 板1 と 対止機 度4 との間には、いわゆる、強いつき、が でき、高値にかいても密管性の低下はなく、水分 の使入などが十分防止される。

4. 超面の無本な段は

第1回(a),(b)は従来の複雑対止型半導体機能の 一例の平面型シミび新面図、第2面(a),(b)は不発 例の一美統例の平面型シミび新面図である。

1……放気板、2……半導体果子、3……引出 レリード、4……対止密証、5……ポンディンタ フィヤ、6……穴。

代塩人 并单士 内 成



